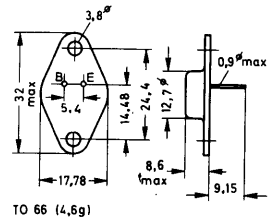


Ausführung Transistoren im Metallgehäuse TO 66, galvanisch mit dem Kollektor verbunden. Durch homogene Basisdiffusion "Homobase®" besonders gegen 2. Durchbruch geschützt.

Anwendung Leistungsschalter, Treiberstufen und Verstärker.



Grenzwerte bei  $T_G = 25^\circ\text{C}$

Kollektor-Basis-Spannung	$U_{CBO}$	90	V
Kollektor-Emitter-Spannung	$U_{CEO}$	55	V
$R_{BE} = 100 \Omega$ $U_{BE} = -1,5 \text{ V}$	$U_{CER}$	60	
	$U_{CEX}$	90	
Emitter-Basis-Spannung	$U_{EBO}$	7	V
Kollektorstrom	$I_C$	4	A
Basisstrom	$I_B$	2	A
Gesamtverlustleistung	$P_{tot}$	29	W
Sperrschichttemperatur	$T_j$	200	$^\circ\text{C}$
Lagertemperatur	$T_S$	-65... 200	$^\circ\text{C}$
Wärmewiderstand			$^\circ\text{C}/\text{W}$
Sperrschicht/Gehäuse	$R_{thG}$	< 6	

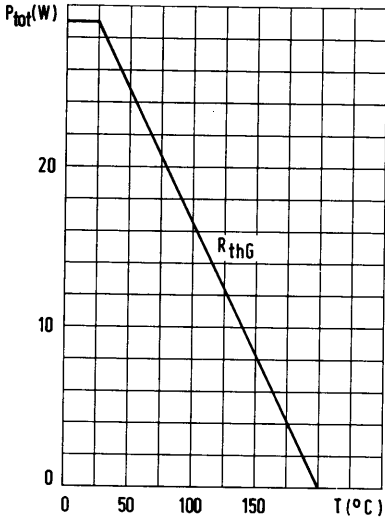
Allgemeine Kennwerte bei  $T_G = 25^\circ\text{C}$

Emitter-Basis- Reststrom	$U_{EBO} = 7 \text{ V}$		$I_{EBO}$	< 1	mA
Kollektor-Emitter- Reststrom $U_{BE} = -1,5 \text{ V}$ $T_G = 150^\circ\text{C}$	$U_{CEX} = 90 \text{ V}$		$I_{CEX}$	< 1	mA
	$U_{CEX} = 30 \text{ V}$			< 5	
Emitter-Basis- Durchbruchspannung	$I_{EBO} = 1 \text{ mA}$		$U_{(BR)EBO}$	> 7	V
Kollektor-Emitter- Durchbruchspannung	$I_{CEO} = 100 \text{ mA}$		$U_{(BR)CEO}^*$	> 55	V
Kollektor-Emitter- Durchbruchspannung	$I_{CER} = 100 \text{ mA}$ $R_{BE} = 100 \Omega$		$U_{(BR)CER}^*$	> 60	V
Kollektor-Emitter- Restspannung	$I_C = 500 \text{ mA}$ $I_B = 50 \text{ mA}$		$U_{CEsat}$	< 1	V
Basis-Emitter- Spannung	$U_{CE} = 4 \text{ V}$ $I_C = 500 \text{ mA}$		$U_{BE}$	< 1,7	V
statische Strom- verstärkung	$U_{CE} = 4 \text{ V}$ $I_C = 500 \text{ mA}$	2 N 3054	h21E	25...100	
		BDY 71		80...200	
Transitfrequenz	$U_{CE} = 10 \text{ V}$ $I_C = 200 \text{ mA}$		$f_T$	> 0,8	MHz

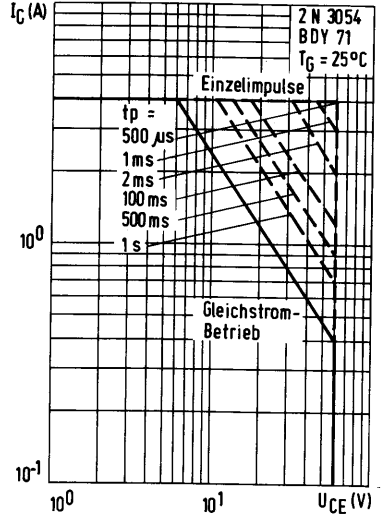
\* Impulsweise gemessen:  $t_p = 300 \mu\text{s}$ ,  $\delta \leq 2\%$



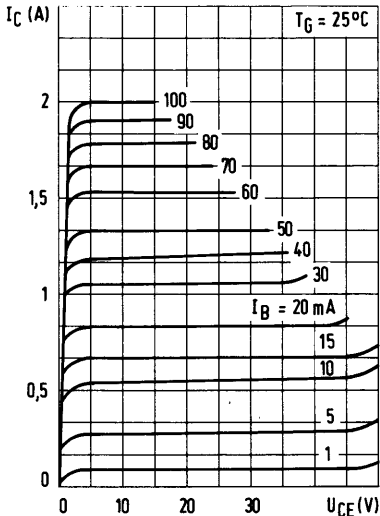
Zulässige  
Gesamtverlustleistung  
 $P_{tot} = f(T)^*$



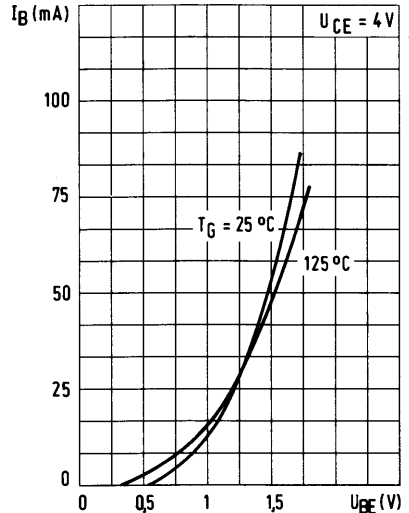
Zulässiger Arbeitsbereich  
 $I_C = f(U_{CE})$

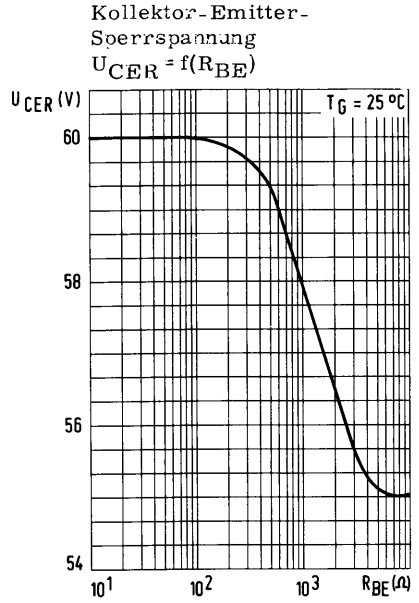
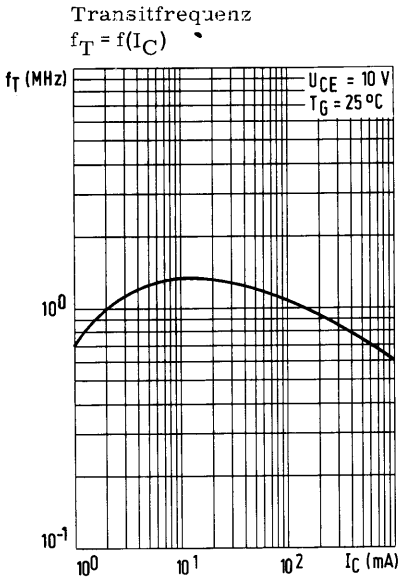


Ausgangskennlinien  
 $I_C = f(U_{CE})$



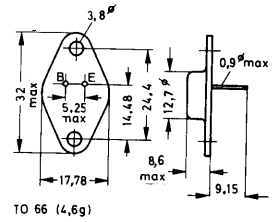
Eingangskennlinien  
 $I_B = f(U_{BE})$





Ausführung Transistoren im Metallgehäuse TO 66, galvanisch mit den Kollektor verbunden. Durch homogene Basisdiffusion "Homobase®" besonders gegen 2. Durchbruch geschützt.

Anwendung Leistungsschalter und Verstärker.



Grenzwerte bei  $T_G = 25^\circ\text{C}$

		BDY 72	2 N 3441	
Kollektor-Basis-Spannung	$U_{CBO}$	150	160	V
Kollektor-Emitter-Spannung	$U_{CEO}$	120	140	V
$R_{BE} = 100 \Omega$	$U_{CER}$	130	150	
$U_{BE} = -1,5 \text{ V}$	$U_{CEX}$	150	160	
Emitter-Basis-Spannung	$U_{EBO}$	7		V
Kollektorstrom	$I_C$	3		A
Basisstrom	$I_B$	2		A
Gesamtverlustleistung	$P_{tot}$	25		W
Sperrschichttemperatur	$T_j$	200		$^\circ\text{C}$
Lagertemperatur	$T_S$	-65... 200		$^\circ\text{C}$
Wärmewiderstand				$^\circ\text{C}/\text{W}$
Sperrschicht/Gehäuse	$R_{thG}$	<7		

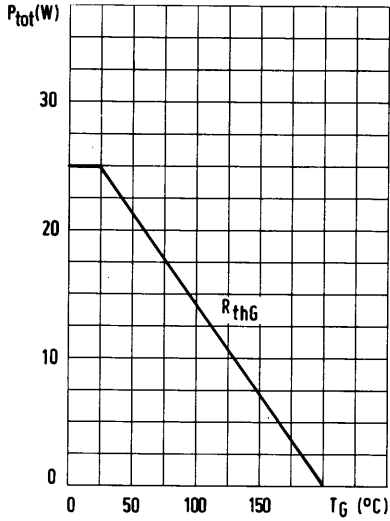
Allgemeine Kennwerte bei  $T_G = 25^\circ\text{C}$

Emitter-Basis-Reststrom	$U_{EBO} = 7 \text{ V}$		$I_{EBO}$	<1	mA
Kollektor-Emitter-Reststrom $U_{BE} = -1,5 \text{ V}$ $T_G = 150^\circ\text{C}$	$U_{CEX} = 130 \text{ V}$ $U_{CEX} = 140 \text{ V}$	BDY 72 2 N 3441	$I_{CEX}$	<1	mA
	$U_{CEX} = 130 \text{ V}$ $U_{CEX} = 140 \text{ V}$	BDY 72 2 N 3441		<5	
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung	$I_{CEO} = 0,1 \text{ A}$	BDY 72	$U_{(BR)CEO}^*$	>120	V
		2 N 3441		>140	
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung	$I_{CER} = 0,1 \text{ A}$ $R_{BE} = 100 \Omega$	BDY 72	$U_{(BR)CER}^*$	>130	V
		2 N 3441		>150	
		$I_{CEX} = 0,1 \text{ A}$ $U_{BE} = -1,5 \text{ V}$		BDY 72 2 N 3441	
Kollektor-Emitter-Restspannung	$I_C = 0,5 \text{ A}$ $I_B = 0,05 \text{ A}$		$U_{CEsat}$	<1	V
Basis-Emitter-Spannung	$I_C = 0,5 \text{ A}$ $U_{CE} = 4 \text{ V}$		$U_{BE}$	<1,7	V
Statische Stromverstärkung bei $U_{CE} = 4 \text{ V}$	$I_C = 0,5 \text{ A}$	BDY 72	h <sub>21 E</sub>	60... 180	
		2 N 3441		20... 80	
Transitfrequenz	$I_C = 0,2 \text{ A}$ $U_{CE} = 10$	BDY 72	$f_T$	>0,8	MHz

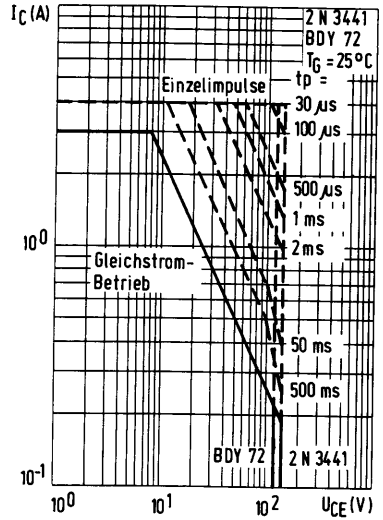
\* Impulsweise gemessen:  $t_p = 300 \mu\text{s}$ ,  $\delta \leq 2\%$



Zulässige  
Gesamtverlustleistung  
 $P_{tot} = f(T_G)$

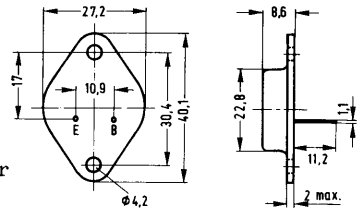


Zulässiger Arbeitsbereich  
 $I_C = f(U_{CE})$



Ausführung Transistoren im Metallgehäuse TO 3 (DIN 3 A 2), galvanisch mit dem Kollektor verbunden. Durch homogene Basisdiffusion "Homobase®" besonders gegen 2. Durchbruch geschützt.

Anwendung Stabilisierte Netzteile Spannungswandler Leistungsverstärker, Ultraschall-Generator.



TO 3

Grenzwerte bei  $T_G = 25^\circ\text{C}$

Kollektor-Basis-Spannung	$U_{CBO}$	100	V
Kollektor-Emitter-Spannung	$U_{CEO}$	60	V
$R_{BE} = 100 \Omega$	$U_{CER}$	70	
$U_{BE} = -1,5 \text{ V}$	$U_{CEX}$	100	
Emitter-Basis-Spannung	$U_{EBO}$	7	V
Kollektorstrom	$I_C$	15	A
Basisstrom	$I_B$	7	A
Gesamtverlustleistung	$P_{tot}$	117	W
Sperrschichttemperatur	$T_j$	200	$^\circ\text{C}$
Lagertemperatur	$T_S$	-65... 200	$^\circ\text{C}$
Wärmewiderstand			$^\circ\text{C}/\text{W}$
Sperrschicht/Gehäuse	$R_{thG}$	<1,5	



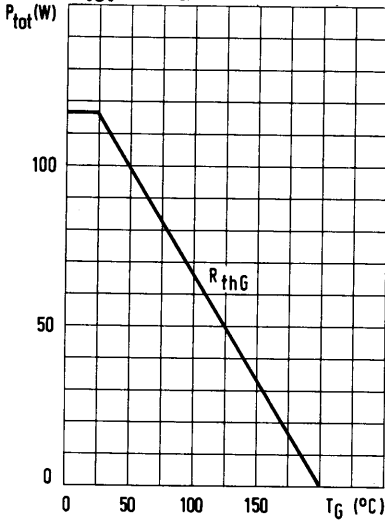
Allgemeine Kennwerte bei  $T_G = 25^\circ\text{C}$

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung	$I_C = 200\text{ mA}$	$U_{(BR)CEO}^*$	> 60	V
	$I_{CER} = 200\text{ mA}$ $R_{BE} = 100$	$U_{(BR)CER}^*$	> 70	
	$I_{CEV} = 100\text{ mA}$ $U_{BE} = -1,5\text{ V}$	$U_{(BR)CEX}^*$	> 100	
Kollektor-Emitter-Restspannung	$I_C = 4\text{ A}$ $I_B = 0,4\text{ A}$	$U_{CEsat}^*$	< 1,1	V
Basis-Emitter-Spannung	$I_C = 4\text{ A}$ $U_{CE} = 4\text{ V}$	$U_{BE}$	< 1,8	V
Emitter-Basis-Reststrom	$U_{EBO} = 7\text{ V}$	$I_{EBO}$	< 5	mA
Kollektor-Emitter-Reststrom $U_{BE} = -1,5\text{ V}$ bei $T_G = 150^\circ\text{C}$	$U_{CEX} = 100\text{ V}$	$I_{CEX}$	< 5	mA
	$U_{CEX} = 60\text{ V}$		< 10	
statische Stromverstärkung	$U_{CE} = 4\text{ V}$ $I_C = 4\text{ A}$	$h_{21E}^*$	20... 70	
Transitfrequenz	$U_{CE} = 10\text{ V}$ $I_C = 1\text{ A}$	$f_T$	> 0,8	MHz

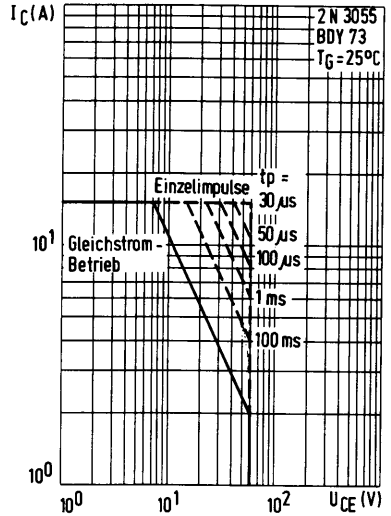
\* Impulsweise gemessen:  $t_p = 300\ \mu\text{s}$ ,  $\delta < 2\%$



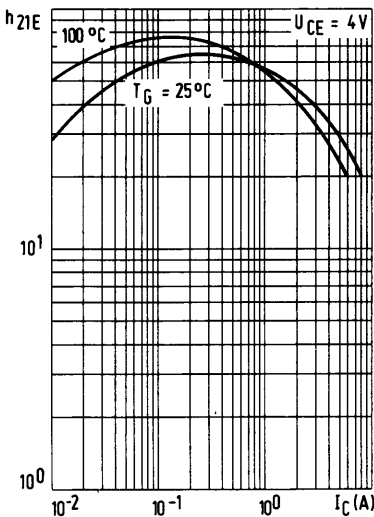
Zulässige  
Gesamtverlustleistung  
 $P_{tot} = f(T_G)$



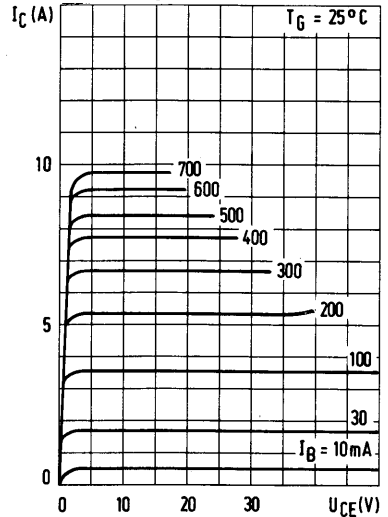
Zulässiger Arbeitsbereich  
 $I_C = f(U_{CE})$



Statische Stromverstärkung  
 $h_{21E} = f(I_C)$

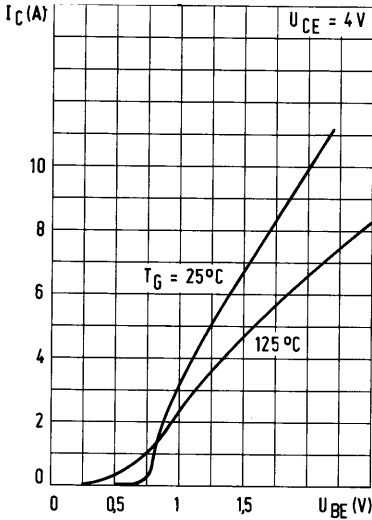


Ausgangskennlinien  
 $I_C = f(U_{CE})$



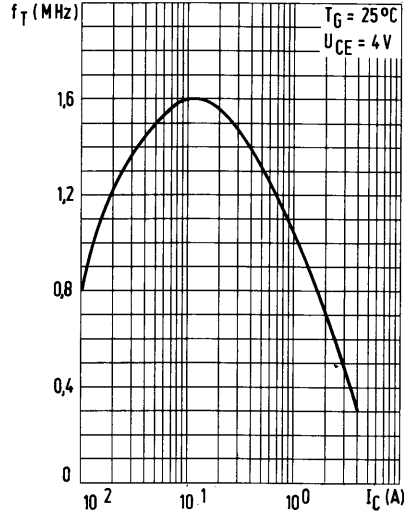
Kollektorstrom

$$I_C = f(U_{BE})$$



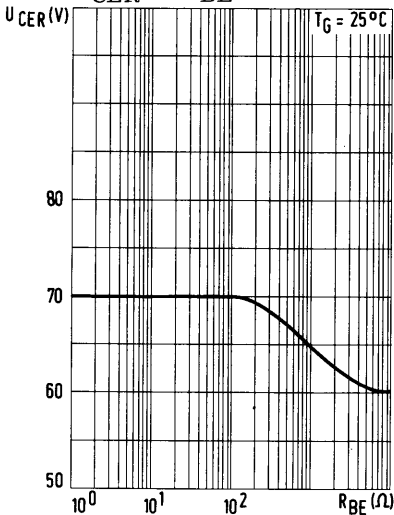
Transitfrequenz

$$f_T = f(I_C)$$



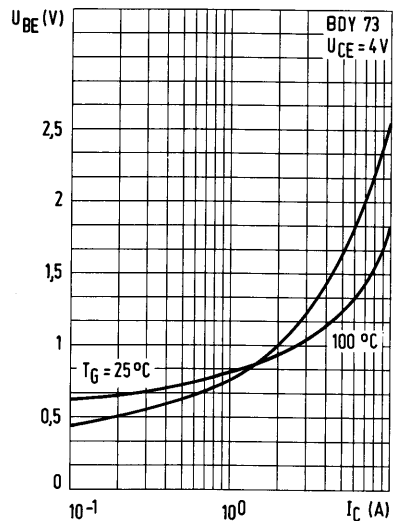
Kollektor-Emitter-Sperrspannung

$$U_{CER} = f(R_{BE})$$



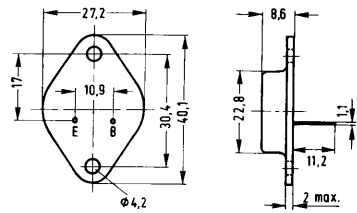
Basis-Emitter-Spannung

$$U_{BE} = f(I_C)$$



Ausführung Transistoren im Metallgehäuse TO 3(DIN 3A 2), galvanisch mit dem Kollektor verbunden. Durch homogene Basisdiffusion "Homobase®" besonders gegen 2. Durchbruch geschützt.

Anwendung Leistungsschalter und Verstärker.



10 3

Grenzwerte bei  $T_G = 25^\circ\text{C}$

		2 N 3442	BDY 74	
Kollektor-Basis-Spannung	$U_{CBO}$	160	150	V
Kollektor-Emitter-Spannung	$U_{CEO}$	140	120	V
$R_{BE} = 100 \Omega$	$U_{CER}$	150	130	
$U_{BE} = -1,5 \text{ V}$	$U_{CEX}$	160	150	
Emitter-Basis-Spannung	$U_{EBO}$	7		V
Kollektorstrom	$I_C$	10		A
Basisstrom	$I_B$	7		A
Gesamtverlustleistung	$P_{tot}$	117		W
Sperrschichttemperatur	$T_j$	200		$^\circ\text{C}$
Lagertemperatur	$T_S$	-65... 200		$^\circ\text{C}$
Wärmewiderstand				$^\circ\text{C}/\text{W}$
Sperrschicht/Gehäuse	$R_{thG}$	<1,5		

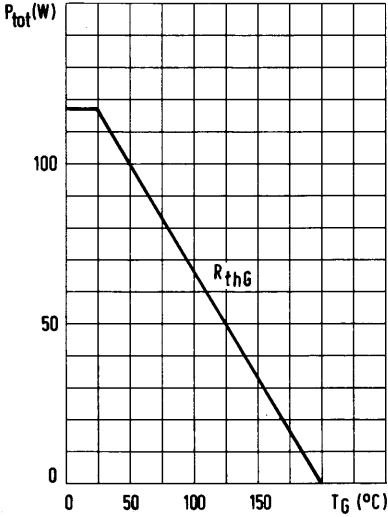
Allgemeine Kennwerte bei  $T_G = 25^\circ\text{C}$

Kollektor-Basis- Reststrom	$U_{CBO} = 130 \text{ V}$ $U_{CBO} = 140 \text{ V}$	BDY 74 2 N 3442	$I_{CBO}$	<1	mA
Emitter-Basis- Reststrom	$U_{EBO} = 7 \text{ V}$		$I_{EBO}$	<5	mA
Kollektor-Emitter- Reststrom $U_{BE} = -1,5 \text{ V}$	$U_{CEX} = 140 \text{ V}$ $U_{CEX} = 130 \text{ V}$	2 N 3442 BDY 74	$I_{CEX}$	<1	mA
Kollektor-Emitter- Durchbruchspannung  $U_{BE} = -1,5 \text{ V}$	$I_{CEO} = 0,2 \text{ A}$	2 N 3442	$U_{(BR)CEO}$	>140	V
		BDY 74		>120	
	$I_{CEX} = 0,1 \text{ A}$	2 N 3442	$U_{(BR)CEX}$	>160	
		BDY 74		>150	
Kollektor-Emitter- Restspannung	$I_C = 3 \text{ A}$ $I_B = 0,3 \text{ A}$	2 N 3442 BDY 74	$U_{CEsat}$	<1	V
Basis-Emitter- Spannung	$U_{CE} = 4 \text{ V}$ $I_{CE} = 3 \text{ A}$		$U_{BE}$	<1,7	V
statische Strom- verstärkung	$U_{CE} = 4 \text{ V}$ $I_C = 3 \text{ A}$	BDY 74	$h_{21E}$	50... 150	
		2 N 3442		20... 70	
Transitfrequenz	$U_{CE} = 10 \text{ V}$ $I_C = 1 \text{ A}$		$f_T$	>0,8	MHz

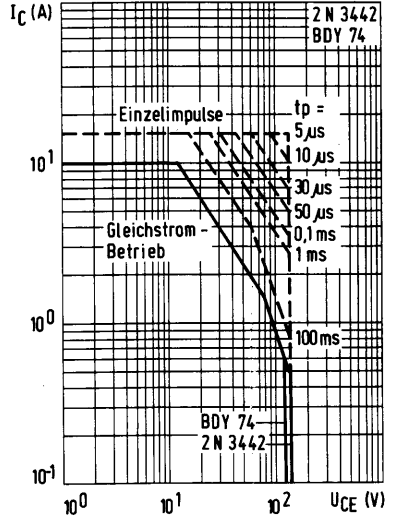
\* Impulswise gemessen:  $t_p = 300 \mu\text{s}$ ,  $\delta \leq 2\%$



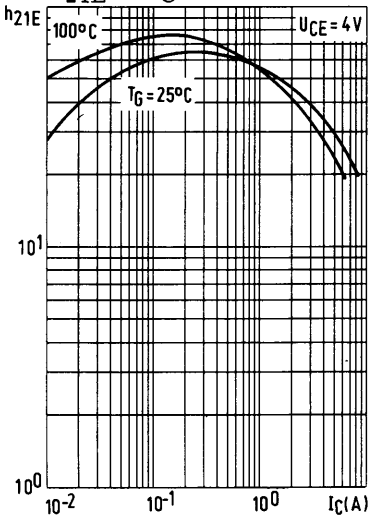
Zulässige  
Gesamtverlustleistung  
 $P_{tot} = f(T_G)$



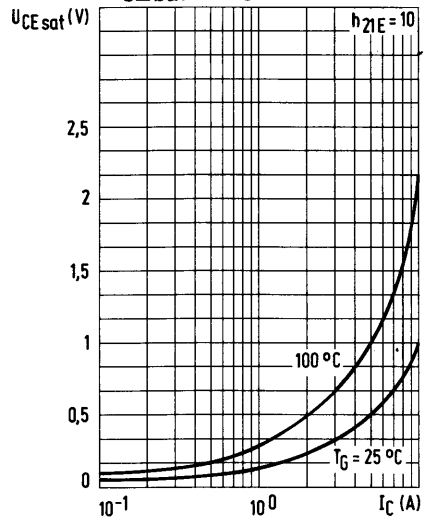
Zulässiger Arbeitsbereich  
Arbeitsbereich



Statische Stromverstärkung  
 $h_{21E} = f(I_C)$

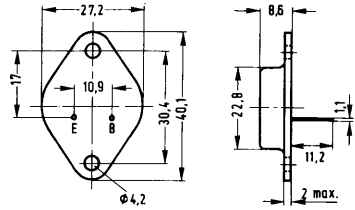


Kollektor-Emitter-  
Restspannung  
 $U_{CEsat} = f(I_C)$



Ausführung Transistoren im Metallgehäuse TO 3 (DIN 3 A 2), galvanisch mit dem Kollektor verbunden. Durch homogene Basisdiffusion "Homobase" besonders gegen 2. Durchbruch geschützt.

Anwendung Leistungsschalter



10 3

Grenzwerte bei  $T_G = 25^\circ\text{C}$

		BDY 76	BDY 77	
Kollektor-Basis-Spannung	$U_{CBO}$	100	150	V
Kollektor-Emitter-Spannung	$U_{CEO}$	60	120	V
bei $R_{BE} = 100 \Omega$	$U_{CER}$	70	135	
bei $U_{BE} = -1,5 \text{ V}$	$U_{CEX}$	80	150	
Emitter-Basis-Spannung	$U_{EBO}$	7		V
Kollektorstrom	$I_C$	20	16	A
Basisstrom	$I_B$	5	4	A
Gesamtverlustleistung	$P_{tot}$	150		W
Sperrschichttemperatur	$T_j$	200		$^\circ\text{C}$
Lagertemperatur	$T_S$	-65... 200		$^\circ\text{C}$
Wärmewiderstand				$^\circ\text{C}/\text{W}$
Sperrschicht/Gehäuse	$R_{thG}$	<1,17		

Allgemeine Kennwerte bei  $T_G = 25^\circ\text{C}$

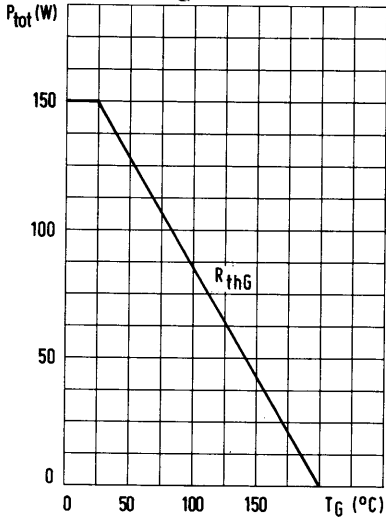
Kollektor-Basis- Reststrom bei $T_G = 150^\circ\text{C}$	$U_{\text{CBO}} = 100 \text{ V}$	BDY 76	$I_{\text{CBO}}$	<5	mA
	$U_{\text{CBO}} = 30 \text{ V}$			<10	
Kollektor-Emitter- Reststrom	$U_{\text{CEO}} = 50 \text{ V}$	BDY 76	$I_{\text{CEO}}$	<10	mA
	$U_{\text{CEO}} = 100 \text{ V}$	BDY 77		<2	
Emitter-Basis- Reststrom	$U_{\text{EBO}} = 7 \text{ V}$		$I_{\text{EBO}}$	<5	mA
Kollektor-Emitter- Reststrom $U_{\text{BE}} = -1,5 \text{ V}$ bei $T_G = 150^\circ\text{C}$	$U_{\text{CEX}} = 100 \text{ V}$	BDY 76	$I_{\text{CEX}}$	<5	mA
	$U_{\text{CEX}} = 130 \text{ V}$	BDY 77		<2	
	$U_{\text{CEX}} = 30 \text{ V}$	BDY 76		<10	
	$U_{\text{CEX}} = 130 \text{ V}$	BDY 77			
Kollektor-Emitter- Durchbruchspannung $U_{\text{BE}} = -1,5 \text{ V}$	$I_{\text{CEO}} = 0,2 \text{ A}$	BDY 76	$U_{(\text{BR})\text{CEO}}^*$	>60	V
		BDY 77		>120	
	$I_{\text{CER}} = 0,2 \text{ A}$ $R_{\text{BE}} = 100 \Omega$	BDY 76	$U_{(\text{BR})\text{CER}}^*$	>70	
$U_{\text{BE}} = -1,5 \text{ V}$	$I_{\text{CEX}} = 0,2 \text{ A}$	BDY 76	$U_{(\text{BR})\text{CEX}}^*$	>80	
	$I_{\text{CEX}} = 0,1 \text{ A}$	BDY 77		>150	
Kollektor-Emitter- Restspannung	$I_{\text{C}} = 10 \text{ A}$ $I_{\text{B}} = 1 \text{ A}$ $I_{\text{C}} = 8 \text{ A}$ $I_{\text{B}} = 0,8 \text{ A}$	BDY 76	$U_{\text{CEsat}}$	<1,4	V
		BDY 77			
Basis-Emitter- Spannung $U_{\text{CE}} = 4 \text{ V}$	$I_{\text{C}} = 10 \text{ A}$ $I_{\text{C}} = 8 \text{ A}$	BDY 76 BDY 77	$U_{\text{BE}}$	<2,2	V
statische Strom- verstärkung $U_{\text{CE}} = 4 \text{ V}$	$I_{\text{C}} = 10 \text{ A}$ $I_{\text{C}} = 8 \text{ A}$	BDY 76 BDY 77	$h_{21\text{E}}^*$	40... 120	
Transitfrequenz $U_{\text{CE}} = 4 \text{ V}$	$I_{\text{C}} = 1 \text{ A}$		$f_{\text{T}}$	>0,8	MHz

\* Impulsweise gemessen:  $t_p = 300 \mu\text{s}, \delta \leq 2\%$

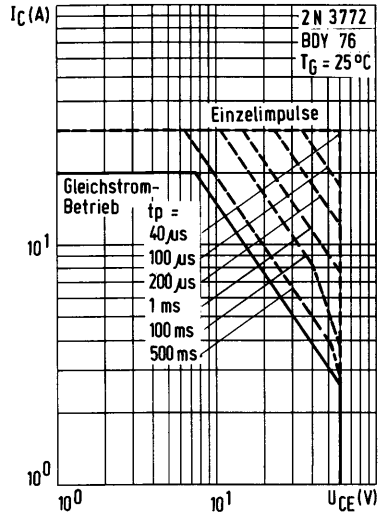




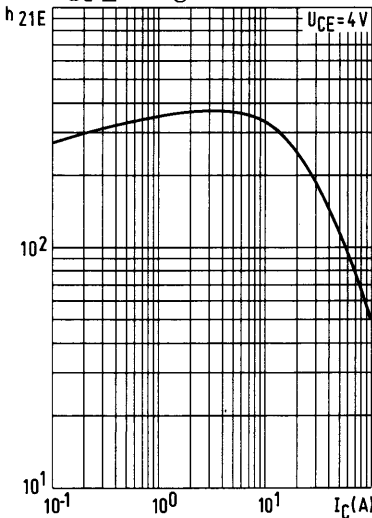
Zulässige  
Gesamtverlustleistung  
 $P_{tot} = f(T_G)$



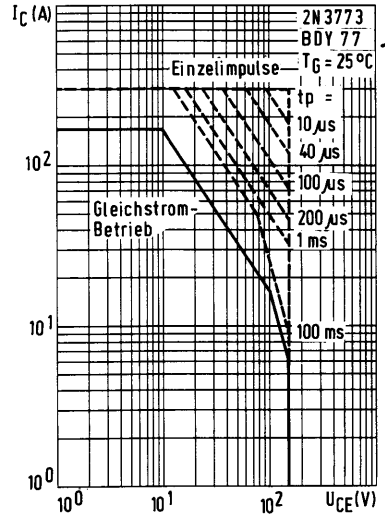
Zulässiger Arbeitsbereich  
 $I_C = f(U_{CE})$



Statische Stromverstärkung  
 $h_{21E} = f(I_C)$

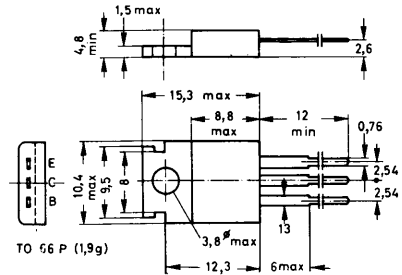


Zulässiger Arbeitsbereich  
 $I_C = f(U_{CE})$



Ausführung Si-Transistoren im Kunststoffgehäuse TO 66 P, Kollektor galvanisch mit der Bodenplatte verbunden, aufschraubbar auf einen Kühlkörper. Durch homogene Basisdiffusion "Homobase<sup>®</sup>" besonders gegen 2. Durchbruch geschützt.

Anwendung NF-Leistungstransistoren für A-Verstärker bzw. mit den Typen BDY 82 und BDY 83 als Komplementärverstärker. Durch die niedrige Sättigungsspannung ebenfalls sehr gut für universelle Schaltanwendungen geeignet.



Grenzwerte bei  $T_U = 25^\circ\text{C}$

		BDY 80	BDY 81	
Kollektor-Basis-Spannung	$U_{\text{CBO}}$	40	60	V
Kollektor-Emitter-Spannung	$U_{\text{CEO}}$	35	50	V
Emitter-Basis-Spannung	$U_{\text{EBO}}$	10		V
Kollektorstrom	$I_{\text{C}}$	4		A
Emitterstrom	$-I_{\text{E}}$	4		A
Gesamtverlustleistung	$P_{\text{tot}}$	1,5		W
bei $T_{\text{G}} = 25^\circ\text{C}$		36		
Sperrschichttemperatur	$T_{\text{j}}$	150		$^\circ\text{C}$
Lagertemperatur	$T_{\text{S}}$	-55... 175		$^\circ\text{C}$
Wärmewiderstand				$^\circ\text{C}/\text{W}$
Sperrschicht/Gehäuse	$R_{\text{thG}}$	$\leq 3,5$		
Sperrschicht/Luft	$R_{\text{thU}}$	$\leq 83$		

vorläufige Daten

Allgemeine Kennwerte bei  $T_U = 25^\circ\text{C}$

Kollektor-Basis- Reststrom	$U_{\text{CBO}} = 20 \text{ V}$		$I_{\text{CBO}}$	< 200	$\mu\text{A}$
Kollektor-Emitter- Reststrom	$U_{\text{CEO}} = 20 \text{ V}$		$I_{\text{CEO}}$	< 10	$\text{mA}$
Emitter-Basis- Reststrom	$U_{\text{EBO}} = 5 \text{ V}$		$I_{\text{EBO}}$	< 100	$\mu\text{A}$
Kollektor-Basis- Durchbruchspannung	$I_{\text{CBO}} = 10 \text{ mA}$	BDY 80	$U_{(\text{BR})\text{CBO}}$	>40	V
		BDY 81		>60	
Emitter-Basis- Durchbruchspannung	$I_{\text{EBO}} = 10 \text{ mA}$		$U_{(\text{BR})\text{EBO}}$	>10	V
Kollektor-Emitter- Durchbruchspannung	$I_{\text{CEO}} = 100 \text{ mA}$	BDY 80	$U_{(\text{BR})\text{CEO}}$	>35	V
		BDY 81		>50	
Kollektor-Emitter- Restspannung	$I_{\text{C}} = 1 \text{ A}$ $I_{\text{B}} = 0,05 \text{ A}$	BDY 80	$U_{\text{CESat}}$	0,2 (<1,0)	V
		BDY 81		0,5 (<1,5)	
Basis-Emitter- Spannung	$U_{\text{CE}} = 5 \text{ V}$ $I_{\text{C}} = 0,5 \text{ A}$		$U_{\text{BE}}$	<0,9	V
statische Strom- verstärkung $U_{\text{CE}} = 5 \text{ V}$	$I_{\text{C}} = 0,5 \text{ A}$		$h_{21\text{E}}^*$	80 (40..240)	
	$I_{\text{C}} = 1 \text{ A}$			55 (>20)	
	$I_{\text{C}} = 2,5 \text{ A}$			25 (>10)	
Transitfrequenz	$-I_{\text{E}} = 0,5 \text{ A}$ $U_{\text{CE}} = 10 \text{ V}$		$f_{\text{T}}$	>0,8	MHz
Kollektor-Sperr- schicht-Kapazität	$U_{\text{CB}} = 10 \text{ V}$ $f = 1 \text{ MHz}$		$C_{\text{b,c}}$	250	$\text{pF}$

\* Stromverstärkungsbereich auf Wunsch eingengt.

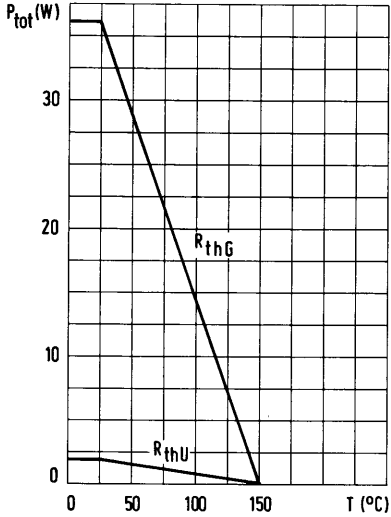
BDY...A	40...80
BDY...B	70...140
BDY...C	120...240



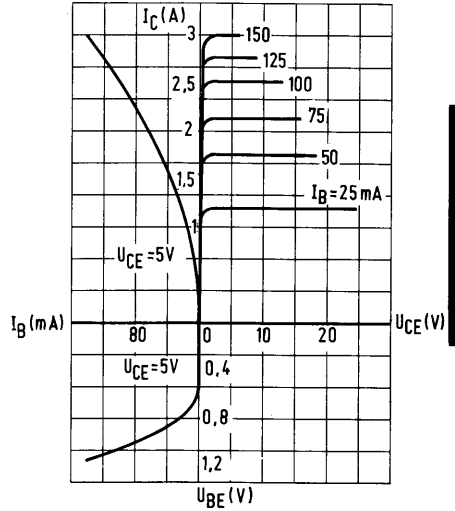
Si-Leistungs-Transistoren NPN

vorläufige Daten

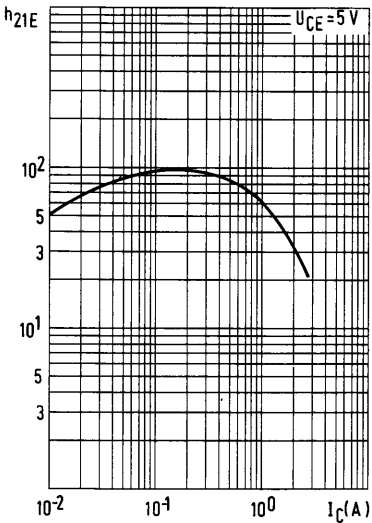
Zulässige  
Gesamtverlustleistung  
 $P_{tot} = f(T)$



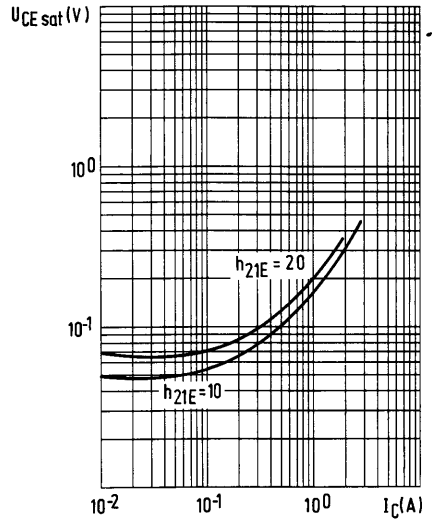
Kennlinien in  
Emitterschaltung



Statische Stromverstärkung  
 $h_{21E} = f(I_C)$

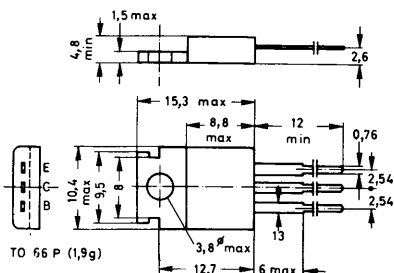


Kollektor-Emitter-  
Restspannung  
 $U_{CEsat} = f(I_C)$



Ausführung Si-Transistoren im Kunststoffgehäuse TO 66 P, Kollektor galvanisch mit der Bodenplatte verbunden, aufschraubbar auf einen Kühlkörper. Durch homogene Basisdiffusion "Homobase" <sup>®</sup> besonders gegen 2. Durchbruch geschützt.

Anwendung NF-Leistungstransistoren für A-Verstärker bzw. mit den Typen BDY 80 und BDY 81 als Komplementärverstärker. Durch die niedrige Sättigungsspannung ebenfalls sehr gut für universelle Schaltungen geeignet.



Grenzwerte bei  $T_U = 25^\circ\text{C}$

		BDY 82	BDY 83	
Kollektor-Basis-Spannung	$-U_{CBO}$	35	50	V
Kollektor-Emitter-Spannung	$-U_{CEO}$	35	50	V
Emitter-Basis-Spannung	$-U_{EBO}$	5		V
Kollektorstrom	$-I_C$	4		A
Emitterstrom	$I_E$	4		A
Gesamtverlustleistung	$P_{tot}$	1,5		$^\circ\text{C}$
bei $T_G = 25^\circ\text{C}$		36		
Sperrschichttemperatur	$T_j$	150		$^\circ\text{C}$
Lagertemperatur	$T_S$	-55... 175		$^\circ\text{C}$
Wärmewiderstand				$^\circ\text{C}/\text{W}$
Sperrschicht/Gehäuse	$R_{thG}$	$\leq 3,5$		
Sperrschicht/Luft	$R_{thU}$	$\leq 83$		

vorläufige Daten

Allgemeine Kennwerte bei  $T_U = 25^\circ\text{C}$

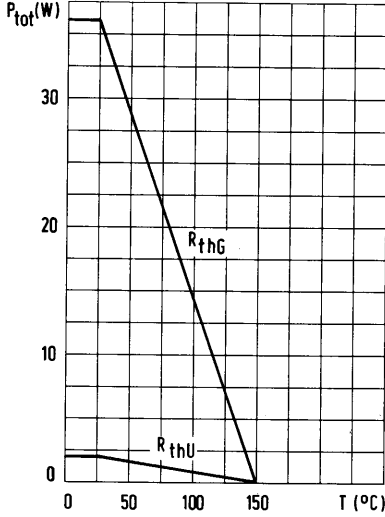
Kollektor-Basis- Reststrom	$-U_{CBO} = 20\text{ V}$		$-I_{CBO}$	<200	$\mu\text{A}$
Kollektor-Emitter- Reststrom	$-U_{CEO} = 35\text{ V}$		$-I_{CEO}$	<10	$\text{mA}$
Emitter-Basis- Reststrom	$-U_{EBO} = 5\text{ V}$		$-I_{EBO}$	<100	$\mu\text{A}$
Kollektor-Basis- Durchbruchspannung	$-I_{CBO} = 10\text{ mA}$	BDY 82	$-U_{(BR)CBO}$	>35	V
		BDY 83		>50	
Emitter-Basis- Durchbruchspannung	$-I_{EBO} = 10\text{ mA}$		$-U_{(BR)EBO}$	>5	V
Kollektor-Emitter- Durchbruchspannung	$-I_{CEO} = 100\text{mA}$	BDY 82	$-U_{(BR)CEO}$	>35	V
		BDY 83		>50	
Kollektor-Emitter- Restspannung	$-I_C = 1\text{ A}$	BDY 82	$-U_{CEsat}$	0,2(<1)	V
	$-I_B = 0,05\text{ A}$	BDY 83		0,5(<1,5)	
	$-I_C = 3\text{ A}$				
	$-I_B = 0,3\text{ A}$				
Basis-Emitter- Spannung	$-U_{CE} = 5\text{ V}$ $-I_C = 0,5\text{ A}$		$-U_{BE}$	<0,9	V
statische Strom- verstärkung	$-I_C = 0,5\text{ A}$		$h_{21E}^*$	80 (40...240)	
	$-I_C = 1\text{ A}$			55 (>20)	
	$-I_C = 2,5\text{ A}$			25(>10)	
$-U_{CE} = 5\text{ V}$					
Transitfrequenz	$I_E = 0,5\text{ A}$ $-U_{CE} = 10\text{ V}$		$f_T$	>0,8	MHz
Kollektor-Sperr- schicht-Kapazität	$-U_{CB} = 10\text{ V}$ $f = 1\text{ MHz}$		$C_{b'c}$	200	$\text{pF}$

\* Stromverstärkung auf Wunsch eingeengt.

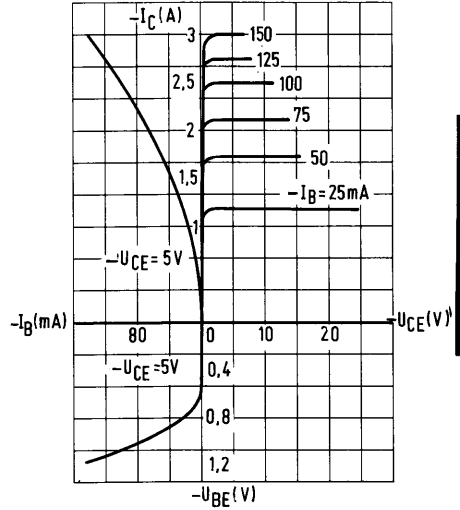
BDY...A	40...80
BDY...B	70...140
BDY...C	120...240



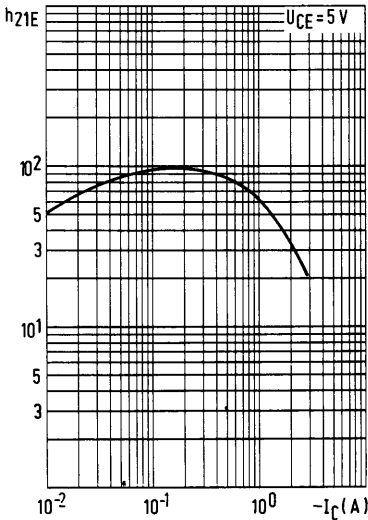
Zulässige  
Gesamtverlustleistung  
 $P_{tot} = f(T)$



Kennlinien  
in Emitterschaltung



Statische Stromverstärkung  
 $h_{21E} = f(I_C)$



Kollektor-Emitter-  
Restspannung  
 $U_{CEsat} = f(I_C)$

